



296/05

Код ОКП 6331291715

Микросхема Н1830ВЕ31

ЭТИКЕТКА

КФДЛ.431281.005 ЭТ

Микросхемы интегральные Н1830ВЕ31

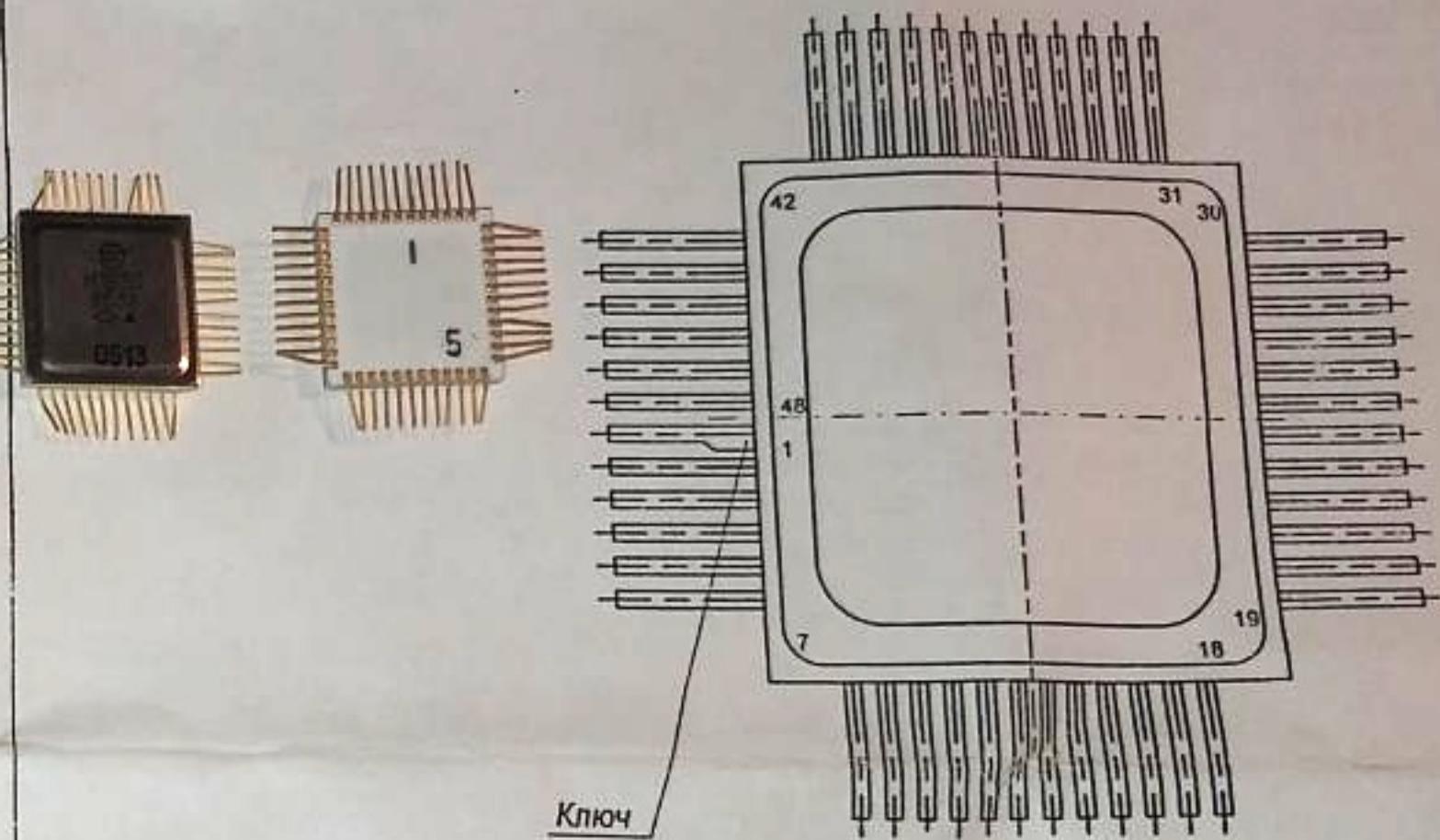
Функциональное назначение: однокристальные микро-ЭВМ.



Заключение
рег.№СВС.01.434.0341.04
до 23.11.2005 г.
ЦОС "Военэлектронсерг"

ГОСТ Р В 20.57.412-97

Схема расположения выводов



Масса микросхемы не более 3,0 г

Пример обозначения микросхем при заказе:

Микросхема Н1830ВЕ31

АЕЯР.431280.070 ТУ

Таблица 1 – Функциональное назначение выводов

Номер вывода	Функциональное назначение вывода	
1-6, 9, 10	Порт 1	Адрес ПЗУ-А(0-7)
11	Сброс	
12	Порт 3	Последовательные данные приемника RXD
13		Последовательные данные передатчика TXD
14		Прерывание О-NTO
15		Прерывание 1-INT1
16		Таймер/счетчик О-ТО
17		Таймер/счетчик 1-T1
20		Запись -WR
21		Чтение - RD
22	Вывод для подключения кварцевого резонатора	
23		Внешняя синхронизация
24	Общий вывод	
26-30, 32-34	Порт 2	Адрес - А(8-15)
35	Разрешение программной памяти	Установка режима чтения ПЗУ (для H1830BE51)
36	Разрешение-фиксации адреса	Установка режима чтения ПЗУ (для H1830BE51)
37	Блокировка работы с внутренней памятью	
38-41, 44-47	Порт 0	Адрес/данные A/D (7-0)
48	Вывод питания от источника напряжения	
7, 8, 18, 19, 25, 31, 42, 43	Не задействованы	

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при температуре от минус 60 °С до плюс 85 °С представлены в таблице 2

Таблица 2

Наименование параметра, единица измерения	Буквен- ное обоз- значение	Норма		При- меч- ние
		не менее	не более	
1 Выходное напряжение высокого уровня сигналов P1(0-7), P2(0-7), P3(0-7), В	U _{OH}	2,4	-	
2 Выходное напряжение <u>высокого</u> уровня сигналов P0(0-7), ALE, PME, В	U _{OHI}	2,4	-	
3 Выходное напряжение низкого уровня сигналов P1(0-7), P2(0-7), P3(0-7), В	U _{OL}	-	0,45	
4 Выходное напряжение <u>низкого</u> уровня сигналов P0(0-7), ALE, PME, В	U _{OLI}	-	0,45	
5 Входной ток высокого уровня сигналов P1(0-7), P2(0-7), P3(0-7), мкА	I _H	-	/-500/	
6 Входной ток низкого уровня сигналов P1(0-7), P2(0-7), P3(0-7), мкА	I _L	-	/-50/	
7 Выходной ток в состоянии "выключено", мкА при U ₀ =0,45 В при U ₀ =5,5 В	I _{OZ}	-	/-10/ 10	
8 Динамический ток потребления, мА	I _{OCС}	-	24	
9 Ток потребления в режиме хранения содержимого регистров спецфункций, мА	I _{CCS1}	-	8,0	
10 Ток потребления в режиме хранения содержимого ОЗУ, мкА	I _{CCS2}	-	100	
11 Внутреннее сопротивление цепи "брос", кОм	R _{SR}	36	125	

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

- золото -	0,0310	г;
- серебро -	0,0505	г;

в том числе:

золото - $0,0539 \cdot 10^{-3}$ г/мм на 48 выводах длиной $(3,5 \pm 0,5)$ мм.

1.3 Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка (Тнм) микросхем в режимах и условиях, допускаемых ТУ, - 100000 ч.

Минимальная наработка (Тнм) микросхем в облегченных режимах, указанных в ТУ, - 120000 ч ($U_{CC} = (5+0,25)$ В, $I_{OL} = 0,5 I_{OL\ max}$).

Минимальный срок сохраняемости микросхем (Тсм) по ОСТ В 11 0398-2000 25 лет.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данной микросхемы требованиям АЕЯР.431280.070 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и ТУ на микросхему.

Гарантийный срок - 25 лет с даты изготовления, а в случае перепроверки микросхемы – с даты перепроверки.

Гарантийная наработка:

- 100000 ч – в типовом режиме;
- 120000 ч - в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы Н1830ВЕ31 соответствуют техническим условиям АЕЯР.431280.070 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению №

6

от

29.04.05 г.

дата

26

Место для штампа ПЗ

Место для штампа
СКК

50

СКК

подпись лица, ответственного за приемку

Место для штампа "Перепроверка произведена" _____

дата

Приняты по извещению №

от

дата

Место для штампа
СКК

Место для штампа ПЗ

подпись лица, ответственного за приемку

Цена договорная